

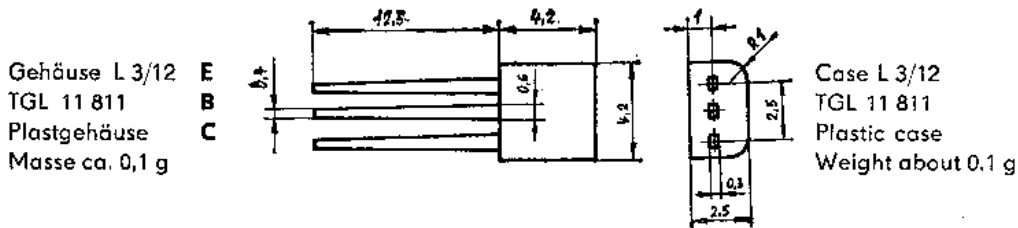
Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-NF-Transistoren
Silicon NPN Epitaxial Planar AF Transistors

Anwendungen: Allgemeine Anwendungen **Application:** General applications

Vergleichbarer Typ: BF 228 **Comparable type:** BF 228

Besondere Merkmale: **Features:**
 ● Hohe Sperrspannung ● High reverse voltage

Abmessungen in mm **Dimensions in mm**



Absolute Grenzwerte

Absolute maximum ratings

	SS 200	SS 201	SS 202
Kollektor-Basis-Spannung Collector-base voltage	70	100	120
Kollektor-Emitter-Spannung Collector-emitter voltage $-U_{BE} = 1\text{ V}$	70	100	120
Emitter-Basis-Spannung Emitter-base voltage		5	
Kollektorstrom Collector current		30	
Basisstrom Base current		10	
Gesamtverlustleistung Total power dissipation $t_{amb} \leq 25\text{ °C}$		150	
Sperrschichttemperatur Junction temperature		100	
Umgebungstemperaturbereich Ambient temperature range		-40 ... +85	
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range		-55 ... +150	

Wärmewiderstand Thermal resistance	Min.	Typ.	Max.
Sperrschicht-Umgebung Junction-ambient			0,5

Statische Kenngrößen
DC characteristics $t_{amb} = 25\text{ °C} \text{ --- } 5\text{ K}$

Kollektor-Emitter-Reststrom Collector cut-off current	SS 200	SS 201	SS 202
$U_{CE} = 70\text{ V}, -U_{BE} = 1\text{ V}$	1 nA	1 nA	1 μA
$U_{CE} = 100\text{ V}, -U_{BE} = 1\text{ V}$	1 nA	1 nA	1 μA
$U_{CE} = 120\text{ V}, -U_{BE} = 1\text{ V}$	1 nA	1 nA	1 μA
Kollektor-Basis-Reststrom Collector cut-off current	SS 200	SS 201	SS 202
$U_{CB} = 70\text{ V}$	< 1	< 1	nA
$U_{CB} = 100\text{ V}$	< 1	< 1	nA
$U_{CB} = 120\text{ V}$	< 1	< 1	nA

	SS 200	SS 201	SS 202
Min.	Typ.	Max.	
Emitter-Basis-Reststrom Emitter cut-off current $U_{EB} = 5\text{ V}$		100 pA	100 nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung Collector-emitter breakdown voltage $I_C = 1\text{ mA}$	60	75	100
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector saturation voltage $I_B = 31\text{ μA}, I_C = 1\text{ mA}$		0,15	0,6
Basis-Emitter-Sättigungsspannung Base saturation voltage $I_B = 31\text{ μA}, I_C = 1\text{ mA}$		0,67	
Basis-Emitter-Spannung Base-emitter voltage $U_{CE} = 3\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}$		0,73	
Gleichstromverstärkung DC forward current transfer ratio $U_{CE} = 3\text{ V}, I_C = 10\text{ mA}$	32	100	

